

図, 表, 参考文献作成上の注意

1. 図表（含：グラフ, 写真）の説明文, 図表内の説明用語等は全て英文とし, フォントは, Helvetica, 中ゴシック等のゴシック系（英文字）またはSymbol（ギリシャ文字）を使用ください。
2. 説明文, 説明用語は, 最初の文字のみ大文字とし, 2番目以降は小文字としてください（ただし, 固有名詞は除く）。
3. 図表は, 原則として, 著者作成のものをそのまま使用しますので, 説明用語の誤記がないよう十分に留意ください。
4. グラフの縦軸/横軸は, 名称および単位を必ず指定し, 適切な間隔で目盛を入れてください。ただし, グラフ内には目盛線を入れないこと。
5. 表は横罫線のみ使用して作成ください。縦罫線は使用しないこと。
6. 写真は, 焼き付けた陽画またはJ P E G形式で保存したファイルを提出ください。
7. 他の文献より引用したものは, 説明文の右肩に参考文献番号を入れてください。
8. ホームページ, カタログ等は参考文献に入れず, 脚注としてください。
9. 図表作成に使用されるアプリケーションソフトによっては, 当方のパソコン環境で開けない場合もありますので, スキヤナでの読み取りに耐える鮮明な図表のハードコピーを原稿に添付ください。

以下に, 図表のサンプルを示します。

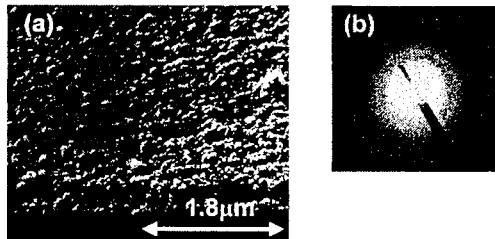


Fig. 4 (a) SEM image of a film prepared on a substrate at T_s of 300 °C with a 308 nm beam at a fluence of 0.2 $\text{Jcm}^{-2}\text{pulse}^{-1}$ and (b) the electron diffraction pattern.

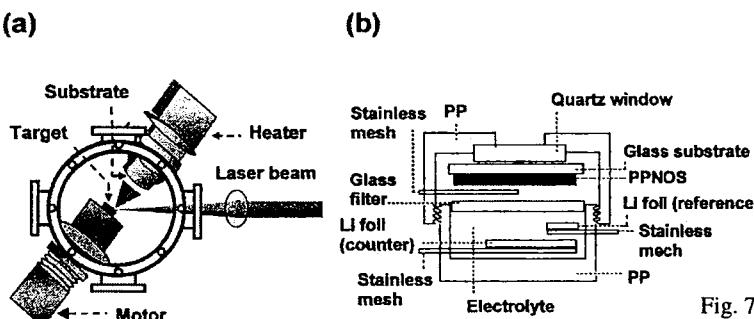


Fig. 1 (a) Schematic representation of the experimental set up for ELA and (b) the cell assembly for lithium ion doping.

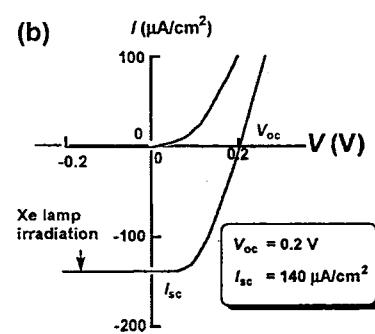
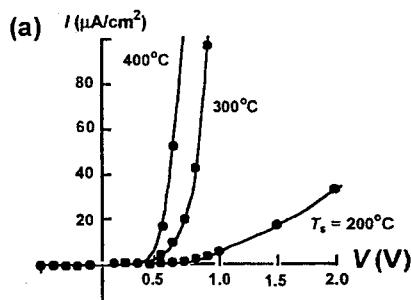


Fig. 5 (a) Dark current-voltage characteristics of a n-Si/PPNOS heterojunction prepared at T_s of 200, 300 and 400 °C and (b) current versus voltage curves in the dark and under illumination for the heterojunction prepared at T_s of 400 °C.

Table 1 Control of electric/electronic properties by selecting ablation conditions.

Wavelength (nm)	Fluence ($\text{Jcm}^{-2}\text{pulse}^{-1}$)	T_s (°C)	Electric cond. (Scm^{-1})	Thermo electric power (μVK^{-1})	Carrier
351	0.2	20	$10^{-6} - 10^{-5}$	-90	electron
308	0.2	20	$10^{-5} - 10^{-4}$		electron
248	0.2	20	$10^{-5} - 10^{-4}$		hole
193	0.2	20	$10^{-5} - 10^{-4}$		hole
308	0.5	20	$10^{-4} - 10^{-3}$		hole
308	4.0	20	10^{-3}		hole